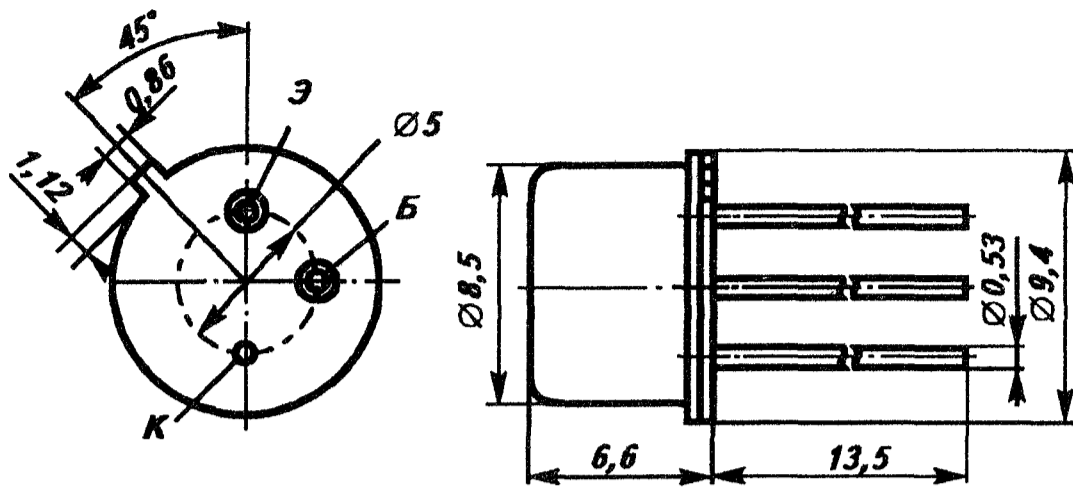


## □ КТ659А

Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный структуры *n-p-n* переключаемый. Предназначен для применения в высокоскоростных переключающих устройствах. Выпускаются в металлоглазном корпусе с гибкими выводами. Масса транзистора не более 1,5 г.



КТ659А

### Электрические параметры

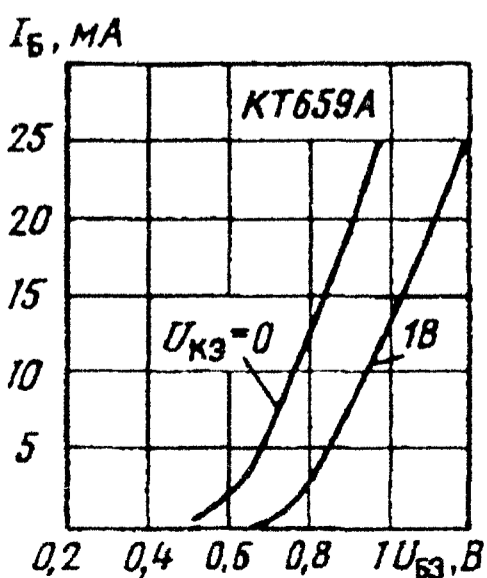
Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кэ} = 1$ В, $I_{к} = 300$ мА, не менее .....	35
типичное значение .....	125
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при $U_{кэ} = 10$ В, $I_{к} = 100$ мА, $f = 100$ МГц, не менее .....	3
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер:	
при $I_{к} = 1$ А, $I_{б} = 0,1$ А, не более .....	0,9 В
типичное значение .....	0,36* В
при $I_{к} = 0,1$ А, $I_{б} = 0,01$ А, не более .....	0,26 В
типичное значение .....	0,11* В
Время включения при $I_{к} = 1$ А, $I_{б} = 0,1$ А, не более .....	40 нс
типичное значение .....	11* нс
Время выключения при $I_{к} = 1$ А, $I_{б} = 0,1$ А, не более .....	80 нс
типичное значение .....	60* нс
Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 10$ В, не более .....	10 пФ
типичное значение .....	6* пФ

### Предельные эксплуатационные данные

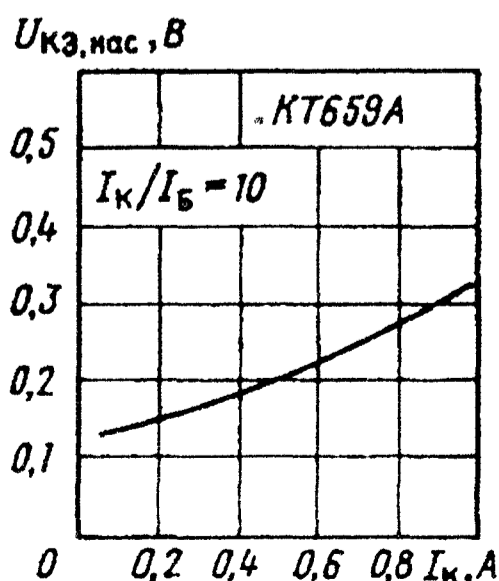
Постоянное напряжение коллектор-база .....	60 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер .....	50 В
Постоянное напряжение база-эмиттер .....	6 В
Постоянный ток коллектора .....	1,2 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора <sup>1</sup> при $T = -45...+25^{\circ}\text{C}$ .....	1 Вт
Температура <i>p-n</i> перехода .....	+180°C
Тепловое сопротивление переход-среда .....	155°C/Вт
Температура окружающей среды .....	-45...+85°C

<sup>1</sup> При  $T > +25^{\circ}\text{C}$  постоянная рассеиваемая мощность коллектора определяется из выражения

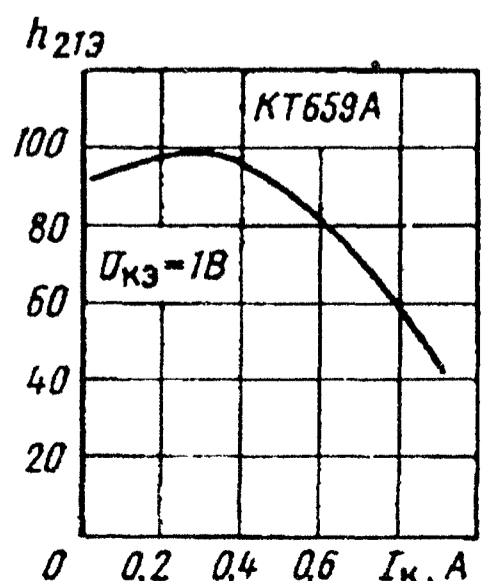
$$P_{к, \text{ макс}} = (180 - T) / 155, \text{ Вт}$$



Зависимости тока базы от напряжения база-эмиттер



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора